

АНОМАЛЬНАЯ СПИНОВАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ДЫРОК В СИЛЬНО ЛЕГИРОВАННОМ КРЕМНИИ

П.Д.Алтухов, К.Н.Ельцов, А.А.Рогачев

Исследованы парамагнитные свойства дырок в сильно легированном Si : В при температуре $T = 1,9\text{K}$. В области перехода Мотта с металлической стороны обнаружено усиление спиновой восприимчивости дырок, обусловленное аномально большим спиновым магнитным моментом дырок вблизи поверхности Ферми.

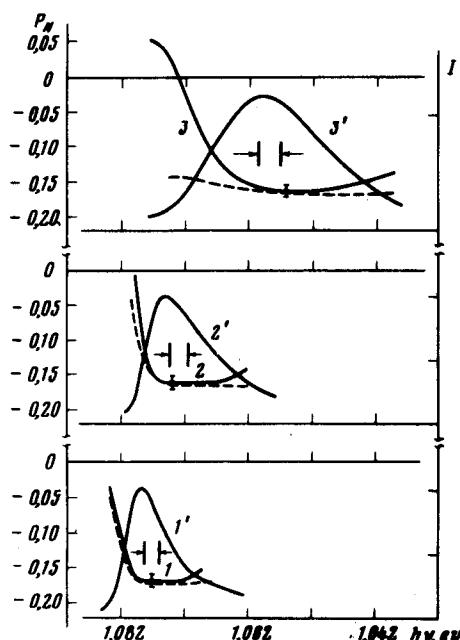
Один из способов исследования перехода Мотта в примесной зоне в полупроводниках основан на измерении спиновой восприимчивости электронов с помощью ЭПР [1 – 3]. Однако в случае акцепторных примесей этот способ не применим, и для измерения спиновой восприимчивости дырок может быть использован метод, основанный на измерении степени циркулярной поляризации рекомбинационного излучения в продольном магнитном поле [4, 5].

В настоящей работе этот метод использован для исследования примесной зоны в кремнии, легированном бором, в области концентраций акцепторов $n_A \approx (2 \cdot 10^{18} + 8 \cdot 10^{18}) \text{ см}^{-3}$, т. е. непосредственно в области перехода Мотта как с диэлектрической, так и с металлической стороны (в Si : В концентрация акцепторов n_C , определяющая переход Мотта, равна $n_C \approx 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ [1]). Одно из достоинств такого метода заключается в возможности измерения спектрального распределения средней проекции спинового момента дырок $\langle j_z \rangle$ на направление магнитного поля H в примесной зоне.

В работе [5] было обнаружено, что в Si : В при $n_A \approx (1 \cdot 10^{17} + 3 \cdot 10^{18}) \text{ см}^{-3}$ в поле $H < 50 \text{ кЭ}$ и $T = 1,9\text{K}$ $\langle j_z \rangle = 0$, что свидетельствует об антиферромагнитной упорядоченности дырок в примесной зоне. Широкие линии излучения при таких n_A связаны с образованием экситонно-примесной зоны, а квазичастица, отвечающая этой зоне, представляет собой экситон (фотовозбужденную $e - h$ -пару), который связан на группе ближайших примесей и способствует антиферромагнитной ориентации ближайших дырок, т. е. приводит к образованию спинового полярона [1].

Как показывают оценки, при $n_A \sim 10^{18} \text{ см}^{-3}$ вклад в энергетическую ширину экситонно-примесной зоны, связанный с интегралом переноса [1], сравним с вкладом, вызванным хаотическим расположением примесей в кристалле, и, таким образом, не исключено, что при $n_A \sim 10^{18} \text{ см}^{-3}$ состояния экситонов не являются локализованными в смысле Андерсона, и экситоны могут двигаться по кристаллу.

Экситонно-примесная зона может существовать при $n_A < n_C$. При $n_A > n_C$ в кристалле возникает металлическая проводимость, носители тока экранируют кулоновское взаимодействие электрона и дырки, и излучение Si : В при $n_A > n_C$ обусловлено рекомбинацией свободных электронов и дырок из примесной зоны. В этом случае спектр излуче-



Спектральное распределение излучения I ($1'$, $2'$, $3'$) и степени циркулярной поляризации P_N (1 , 2 , 3) в Si : В магнитном поле $H = 50$ кЭ при температуре $T = 1,9$ К и $H \parallel [1\bar{1}1]$ (TO/LO -линии). 1 , $1' - n_A \sim 2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$; 2 , $2' - n_A \sim 3,6 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$; 3 , $3' - n_A \sim 7,5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Сплошные кривые – эксперимент. Пунктирные – спектральное распределение величины $\frac{1}{2}\phi_N$ обусловленное TO/LO -расщеплением (расчет). Вертикальные отрезки указывают погрешность

ния при низком уровне возбуждения отражает плотность состояний дырок в примесной зоне, а ширина линий излучения определяется энергией Ферми дырок E_F^h .

На рисунке показаны спектры излучения и поляризации TO/LO – линий излучения образцов Si : В. Рассмотрим сначала данные при $n_A < n_C$. Как известно, TO - и LO -линии в кремнии расщеплены в спектре на величину $E_{LO} - E_{TO} = 1,8$ мэВ, и LO -линия находится выше по энергии TO -линии. Отношение интенсивностей этих линий $I_{LO}/I_{TO} \approx 0,11$ [6], а константы, характеризующие поляризацию излучения, имеют противоположные знаки ($\phi_{TO} = 0,4$, $\phi_{LO} = -0,45$ [4]). Вследствие этого величина $-\frac{1}{2}\phi_N$, равная степени поляризации TO/LO -линий излучения в поле $H \gtrsim 50$ кЭ при $\langle j_z \rangle = 0$, зависит от энергии кванта излучения $h\nu$, при этом среднее значение величины $-\frac{1}{2}\phi_N$, равно $P_N^0 = -\frac{1}{2}\phi_N^0 \approx 0,16$ [4, 5]. Величина $-\frac{1}{2}\phi_N$, показанная пунктиром на рис. 1, практически постоянна в основной части линии излучения и уменьшается по абсолютной величине на коротковолновом краю. Из рис. 1 видно,

что теоретические кривые при $n_A \approx 2,2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ и $n_A \approx 3,6 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ практически совпадают с экспериментальными, и, таким образом, при этих n_A (вблизи n_C с диэлектрической стороны) $\langle j_z \rangle \approx 0$.

Для широкой линии излучения при $n_A \approx 7,5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ $TO - LO$ -расщепление не существенно, и величина $\frac{1}{2}\phi_N$ слабо зависит от $h\nu$. Однако экспериментальная кривая при $n_A \approx 7,5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ (вблизи n_C с металлической стороны) в коротковолновой части линии излучения сильно отличается от теоретической, и, следовательно, в этом случае $\langle j_z \rangle \neq 0$.

Можно показать, что при $|\frac{P_N - P_N^o}{P_N^o}| \ll 1$, где P_N — средняя степень поляризации линии излучения, средний момент дырок в примесной зоне и в поле $H \gtrsim 50 \text{ кЭ}$ равен $\langle j_z \rangle \approx \alpha_N \frac{P_N - P_N^o}{P_N^o}$ (для TO/LO -линии $\alpha_N \approx 0,78$). По кривым 3,3' мы определили, что при $n_A \approx 7,5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ в поле $H = 50 \text{ кЭ}$ $\langle j_z \rangle = -0,11$. Для вырожденных дырок в кремнии па-

рамагнетизм Паули дает $\langle j_z \rangle^P = -\frac{15}{8} g_1 \frac{\mu_0 H}{E_F^h}$ [4], где $g_1 \approx 1,2$ [4] —

g — фактор дырок, μ_0 — магнетон Бора. При $n_A \approx 7,5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ в кремнии $E_F^h \approx 25 \text{ мэВ}$, и в поле $H = 50 \text{ кЭ}$ $\langle j_z \rangle^P \approx -0,027$. Следовательно, фактор усиления спиновой восприимчивости дырок при $n_A \approx 7,5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ равен $\frac{\chi_h}{\chi_h^P} = \frac{\langle j_z \rangle}{\langle j_z \rangle^P} \approx 4$, где χ_h^P — восприимчивость Паули, χ_h — наблю-

даемое значение восприимчивости. Это значительное усиление восприимчивости связано с аномально большим магнитным моментом дырок вблизи поверхности Ферми, поскольку существенное изменение степени поляризации излучения наблюдается в коротковолновой части линии. Фактически разность между экспериментальной и теоретической кривой отражает спектральное распределение величины $\langle j_z \rangle$ в примесной зоне, и по кривой 3 на рис. I можно определить, что величина магнитного момента дырок вблизи поверхности Ферми более чем на порядок превышает значение, обусловленное парамагнетизмом Паули.

Ранее в опытах по ЭПР в Si: P [2, 3] наблюдалось усиление спиновой восприимчивости электронов, которое было интерпретировано как следствие существования локализованных моментов в металлических образцах. Эта точка зрения получила дальнейшее подтверждение в работах [7, 8]. Как показано в [1], однократно занятые локализованные состояния, дающие вклад в усиление спиновой восприимчивости, должны находиться вблизи поверхности Ферми, и, таким образом, предположение о существовании локализованных моментов не противоречит результатам настоящей работы. Вместе с тем существует и другая точка зрения [1, 9, 10], согласно которой усиление спиновой восприимчивости может быть связано с возникновением сильно коррелированного газа Бринкмана и Райса [9], и вопрос о том, какой из этих механизмов приводит к аномально большому магнитному моменту дырок вблизи поверхности Ферми, требует более подробного рассмотрения.

В заключение авторы приносят благодарность В.М.Аснину за полезные дискуссии, а также Б.С.Явичу и Л.А.Делимовой за предоставленные ные образцы Si: B.

Физико-технический институт
им. А.Ф.Иоффе
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
6 января 1980 г.

Литература

- [1] Н.Ф.Мотт. Переходы металл – изолятор, М., изд. Наука, 1979.
- [2] H. Ue, S.MaeKawa. Phys. Rev., B, 3, 4232, 1971.
- [3] J.D.Quirt, J.R.Marko. Phys. Rev., B, 7, 3842, 1973.
- [4] П.Д.Алтухов, Г.Е.Пикус, А.А.Рогачев. ФТТ, 20, 489, 1978.
- [5] П.Д.Алтухов, К.Н.Ельцов, А.А.Рогачев. Письма в ЖЭТФ, 31, 30, 1980.
- [6] R.B.Hammond, D.L.Smith, T.C.McGill. Phys. Rev. Lett., 35, 1535, 1975.
- [7] W.Sasaki, S.Ikehata, N.Kobayashi, S.Kobayashi. Proc. 14-th – ICPS, Edinburgh, 1978, p. 923.
- [8] H.Kamimura. Proc. 14-th – ICPS, Edinburgh, 1978, p. 981.
- [9] W.F.Brinkman, T.M.Rice. Phys. Rev. B., 2, 4302, 1970.
- [10] K.A.Chao, K.F.Berggren. Phys. Rev. Lett., 34, 880, 1975.